

Вадим Валентинович Емцев

(к шестидесятилетию со дня рождения)



От всего сердца поздравляем заместителя главного редактора журнала "Физика и техника полупроводников" Вадима Валентиновича Емцева с шестидесятилетним юбилеем.

Закончив в 1964 году Ленинградский политехнический институт и проработав несколько лет на оборонном предприятии в г. Казани, В.В. Емцев пришел в Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе. Более тридцати лет он связан с этим выдающимся центром отечественной науки.

В.В. Емцев успешно работает в области изучения примесных центров и собственных дефектов в алмазоподобных полупроводниках. Большое значение имеют его исследования, посвященные процессам взаимодействия собственных точечных дефектов с различными примесями в кремнии и германии. Последние годы под его руководством проводится интенсивное изучение процессов преципитации кислорода в кремнии, в том числе под действием высокого гидростатического давления. Получен ряд существенных результатов, позволяющих установить основные закономерности в поведении примесей редкоземельных элементов в кремнии. Расширен фронт работ по исследованию дефектов структуры в таких практически важных полупроводниках, как нитрид галлия и нитрид индия.

В.В. Емцев — автор более 140 научных работ, в том числе монографии. Начиная с 1997 года он входит в состав консультативного комитета Международной конференции по дефектам в полупроводниках (ICDS-19, ICDS-20 и ICDS-21). В качестве заместителя главного редактора журнала В.В. Емцев в непростых экономических условиях последних лет активно способствовал обеспечению регулярного выпуска и высокого научного уровня журнала "Физика и техника полупроводников".

Постоянная доброжелательность и обаяние в сочетании с жизненной энергией Вадима Валентиновича делают работу с ним радостной и плодотворной. Желаем Вадиму Валентиновичу в юбилейный год долгих лет жизни, здоровья и творческих успехов.

Коллеги, друзья и коллектив редколлегии журнала